

Information



KD 522 A, KD 522 B

1/86

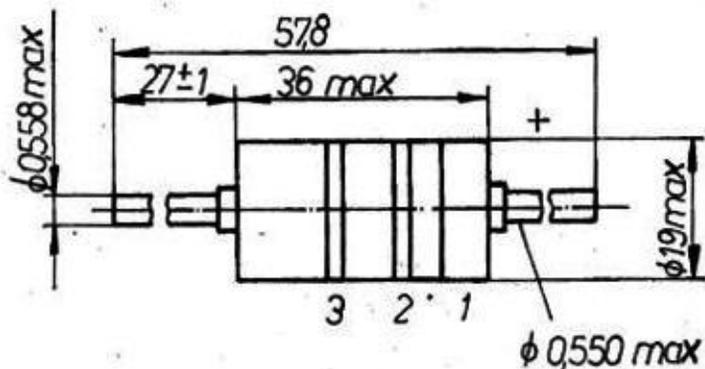
Herstellerland: UdSSR

Übersetzung, bearb.

Allgemeines

Die Silizium-Schaltdioden KD 522 A und KD 522 B sind für den Einsatz in Schaltungen radiotechnischer Geräte und Anlagen und in der Rechen-technik vorgesehen.

Sie sind in einem Glas-Gehäuse untergebracht.
Die Masse der Diode beträgt maximal 0,15 g.



BetriebsbedingungenUmgebungstemperatur $t_{amb} = -60$ bis 125 °CGrenzwerte

Kenngrößen	Kurzzeichen	Wert			Meßbedingungen
		KD 522 A	KD 522 B		
maximale Sperrspannung	U_{Rmax}	30	50	V	$t_{amb} = -60 \dots +125$ °C
maximale Spitzensperrspannung	U_{RMmax}	50	75	V	$t_p \leq 2$ /us $t_{amb} = -60 \dots +125$ °C
maximaler Spitzendurchlaßstrom	I_{FRMmax}	1500	1500	mA	$t_p \leq 10$ /us $t_{amb} = -60 \dots +35$ °C
		500	500		
maximale Sperrschichttemperatur	t_{jmax}	150	150	°C	-

Elektrische Kennwerte

Kenngrößen	Kurzzeichen	Wert			Meßbedingungen
		KD 522 A	KD 522 B		
maximale Sperrspannung	U_{Rmax}	30	50	V	
Sperrgleichstrom	I_R	$\leq 2,0$	$\leq 5,0$	/uA	U_{Rmax}
Durchlaßgleichspannung	U_F	$\leq 1,1$	$\leq 1,1$	V	$I_F = 100$ mA
Gesamtkapazität	C_{tot}	≤ 4	≤ 4	pF	$U_R = 0 \dots 0,05$ V

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen nur informativen Charakter.

Durch die Ziffern 1 und 3 wird die mögliche Streubreite auf der Basis von 95 % der Bauelemente dargestellt.

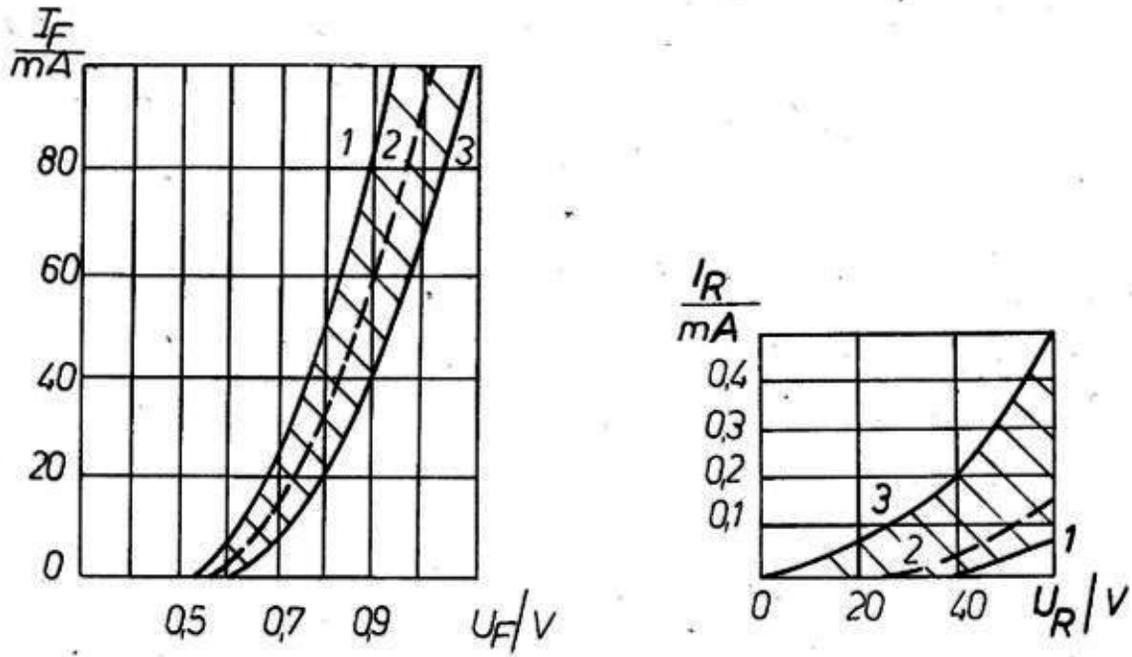


Bild 2: Durchlaßkennlinie bei $t_{\text{amb}} = 25 \pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$

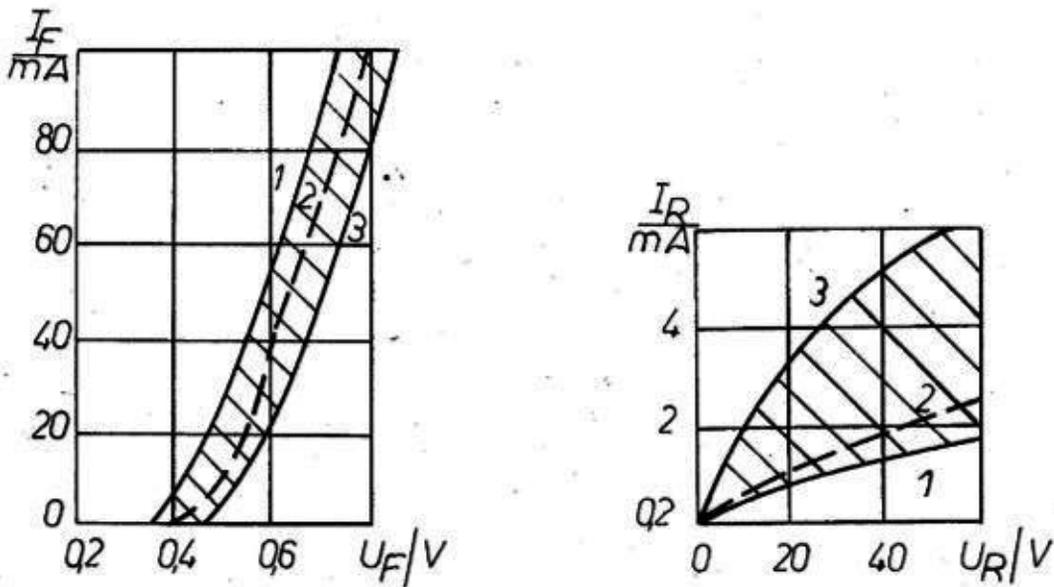


Bild 3: Durchlaßkennlinie bei $t_{\text{amb}} = 85 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$

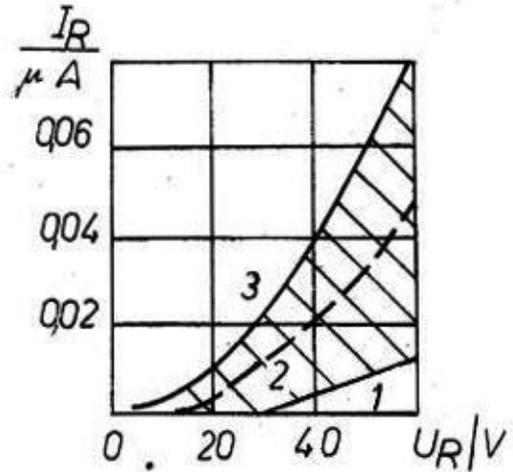
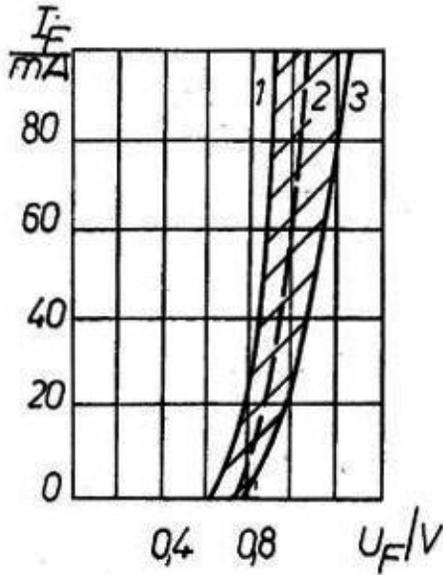


Bild 4: Durchlaßkennlinie bei $t_{amb} = -55 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$

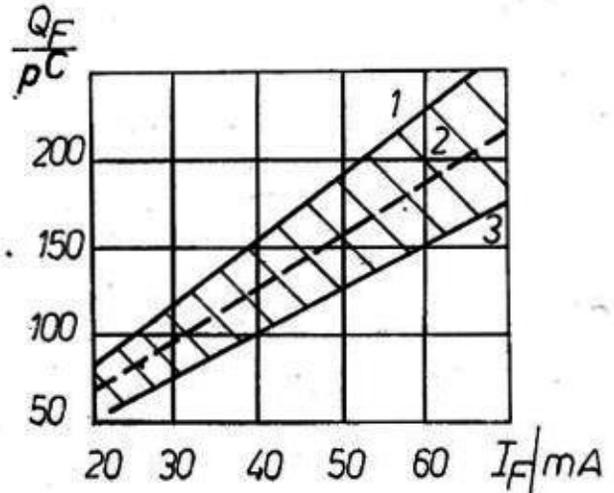
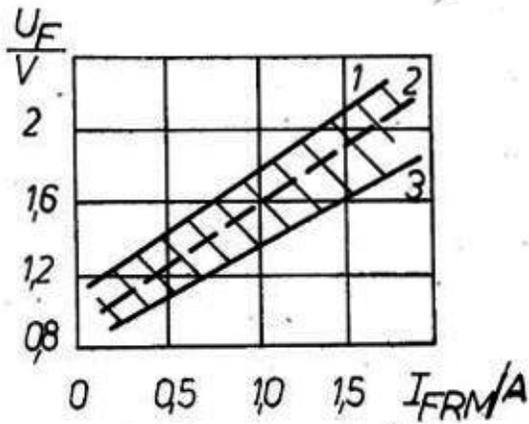


Bild 5: Abhängigkeit der Durchlaßspannung von der Größe des Spitzendurchlaßstroms bei $t_{amb} = 25 \pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$

Bild 6: Abhängigkeit der Erholladung vom Durchlaßgleichstrom ($U_{RM} = 10 \text{ V}$)

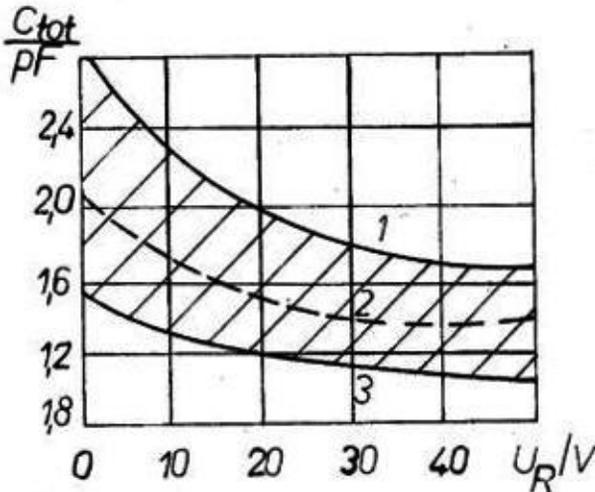


Bild 7: Abhängigkeit der Gesamtkapazität von der Sperrgleichspannung

Anwendungs- und Betriebshinweise

Die Dioden können auf unterschiedliche Weise in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Diodengehäuse so angeschlossen werden, daß eine Erwärmung über 150 °C an einer beliebigen Stelle des Diodengehäuses und ein Durchgang elektrischer Impulse durch die Diode ausgeschlossen werden.

Es wird empfohlen, als Wärmeableitung eine Pinzette mit flachen Schenkeln, die mindestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, zu verwenden.

Die Biegung der Anschlüsse ist zulässig in einem Abstand von mindestens 3 mm vom Diodengehäuse, mit einem Biegeradius von mindestens 1,5 mm.

Bei der Kontrolle der Kennwerte, bei Prüfungen und während des Betriebes dürfen keine mechanischen Kräfte auf die Verbindungsstellen zwischen Anschlüssen und Diodengehäuse wirken, um eine Beschädigung dieser Verbindungsstellen zu verhindern.

Literatur

- /1/ Polupravadnikovye diody Katalog Čast' 1 (Halbleiterdioden Katalog Teil 1), 1979, Elorg Moskva. S. 129

Die vorliegenden Datenblätter dienen
ausschließlich der Information!
Es können daraus keine Liefermög-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Änderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

The logo for RFT (Radio Frequency Technology) features the letters 'R', 'F', and 'T' in a bold, stylized font. Each letter is composed of multiple parallel horizontal lines, giving it a sense of depth and a technical, modern appearance.

Herausgeber:

vab applikationszentrum elektronik berlin
im vab kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25

Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055
